

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOGADOS
AGENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Carrera 9 No. 83-09
Bogotá-Colombia

45-1
42

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00069182 00000001 Folios: 14
Fecha (CND): 2000-11-29 15:30:23
Trámite : CBE PATENTES B 1 REGISTRO/ 449 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00.069.182

Solicitud de Patente de Invención para:

**"PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER UN SUSTRATO ELABORADO
MEDIANTE TECNICA DE VACIO."**

Solicitante: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG e.V.**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, en atención a su auto No. 3330 Notificado por Estado el 12 de Octubre del 2000 y estando dentro del término , atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera :

2. **Respuesta a las observaciones del funcionario examinador :**

2.1 Advierte el funcionario examinador que " No es clara la expresión empleada en la cláusula 2: '...el sustrato mediante técnica de vacío de otro modo'; especificar a que se refieren. En la reivindicación 10 '...en forma estructura??..' la misma observación se aplica'.

De conformidad con esta observación, aclaramos que dichas reivindicaciones presentaban errores de traducción. Por lo tanto, presentamos nuevo capítulo reivindicatorio en el cual las reivindicaciones 2 y 10 se han corregido de tal forma que las expresiones empleadas

especifican claramente a que hacen referencia. Dicha corrección se presenta de la siguiente forma:

2. "Procedimiento conforme a la reivindicación No.1, **CARACTERIZADO** porque, antes del recubrimiento con el monómero orgánico, el sustrato es recubierto en otra parte mediante técnica de vacío.

10 "Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 9, **CARACTERIZADO** porque el recubrimiento se retira en forma estructurada de tal modo que forma una máscara para posteriores pasos de procesamiento".

2.2 "Establece el examinador que las reivindicaciones de procedimiento (métodos, sistemas y procesos) en general, estarán definidos por las diferentes etapas que se llevan a cabo en él, indicando, por cierto, las variables y su respectiva cuantificación".

Para atender a las observación, el solicitante manifiesta que el proceso reivindicado define diferentes etapas que se llevan a cabo en él como por ejemplo: *tratar* una superficie del sustrato mediante técnica de vacío , *recubrir* la superficie tratada con un monómero orgánico;

-*recubrir* el sustrato con forma de banda con el mismo monómero orgánico antes de *conducir* el sustrato mediante un dispositivo guía;

- *recubrir* el sustrato con un monómero orgánico y *retirar* el recubrimiento en forma parcial o completa antes de una elaboración posterior del sustrato mediante técnica de vacío;

- *desprender* el recubrimiento mediante calentamiento y/o mediante haces de electrones, láser, radiación de fotones y/o radiación infrarroja etc.

Con respecto a las variables y su respectiva cuantificación, el solicitante menciona que en el proceso reivindicado es difícil definir parámetros como por ejemplo temperatura y presión debido a los diferentes tipos de

materiales de recubrimiento. Todos los parámetros dependen del material que es utilizado para el recubrimiento.

2.3 "Menciona el examinador que las reivindicaciones se dividen por su forma en independientes y dependientes, las primeras son las que definen a la invención en su forma más general y las segundas definen a fondo cada característica. El capítulo reivindicado presentado no cumple con dichos preceptos".

Con el objeto de atender a esta observación, presentamos un nuevo capítulo reivindicatorio como sustitutivo del anteriormente presentado, donde se cambió la expresión "conforme a una de las reivindicaciones antes mencionadas" por la respectiva reivindicación a la cual corresponden como por ejemplo:

4. "Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADO porque el tratamiento mediante....."

14 "Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 13 CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato un semiconductor.

Vale la pena mencionar que las reivindicaciones 1 y 6 son las reivindicaciones independientes que definen la invención en su forma más general.

2.4 "Advierte el examinador que las reivindicaciones 26 y 27 deben ser eliminadas, se entiende que el procedimiento es para proteger la superficie de un sustrato y éste ya es reclamado (aunque inexactamente) en las cláusulas 1 a 25".

El solicitante no está de acuerdo en eliminar las reivindicaciones 26 y 27 ya que mencionan características que no se establecen en las reivindicaciones 1 a 25; como la protección de una superficie de un sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor o que el

procedimiento se emplea para fabricar una pieza bruta para disco etc. Por lo anterior, el solicitante ha modificado las reivindicaciones 26 y 27 de la siguiente forma:

26 "Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 25, CARACTERIZADO porque se utiliza para proteger una superficie de un sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor, ..."

27 "Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 24 CARACTERIZADO porque se utiliza para fabricar una pieza bruta para disco o una célula solar protegida contra influencias....."

2.5 "Con respecto al título el examinador establece que debe ser redactado conforme a lo que se está protegiendo en el capítulo reivindicatorio".

Con el objeto de atender a esta observación presento nuevo título de la siguiente forma:

"PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER UN SUSTRATO ELABORADO MEDIANTE TECNICA DE VACIO."

Para tal efecto, presento nueva tarjeta temática, de archivo de propietarios y nuevo extracto para la publicación, el cual contiene las principales reivindicaciones de la invención.

3. De acuerdo con las modificaciones introducidas, se adjuntan los siguientes anexos :

- Nuevo capítulo reivindicatorio
- Nuevas tarjetas de archivo temático, de propietarios, y nuevo extracto.

Cumplido así con lo dispuesto, atentamente solicito a Ud. se continúe con el trámite correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención.

Del Señor Jefe,

Margarita Castellanos
Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura

Carrera 9 No. 93 - 09 - Santa Fe de Bogotá

Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Santa Fe de Bogotá, D.C.,

xg1/4770

28 NOV. 2000

6
50
47

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para proteger un sustrato elaborado mediante técnica de vacío de influencias físicas y/o químicas, **CARACTERIZADO** porque se trata una superficie del sustrato mediante técnica de vacío y se recubre a continuación la superficie tratada con un monómero orgánico.

2. Procedimiento conforme a la reivindicación No.1, **CARACTERIZADO** porque, antes del recubrimiento con el monómero orgánico, el sustrato es recubierto en otra parte mediante técnica de vacío.

3. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 ó 2, **CARACTERIZADO** porque el tratamiento mediante técnica de vacío y el recubrimiento en capas con el monómero orgánico se realizan en la misma instalación de vacío.

4. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3, **CARACTERIZADO** porque el tratamiento mediante técnica de vacío y el recubrimiento en capas con el monómero orgánico se realizan en la misma cámara de vacío.

5. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 4, **CARACTERIZADO** porque se recubre el sustrato con forma de banda con el mismo monómero orgánico antes de conducir el sustrato mediante un dispositivo guía.

6. Procedimiento para proteger un sustrato de influencias físicas y/o químicas, **CARACTERIZADO** porque se recubre el sustrato con un monómero orgánico y se retira el recubrimiento en forma parcial o completa antes de una elaboración posterior del sustrato mediante técnica de vacío.

7. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 5, **CARACTERIZADO** porque antes de una elaboración posterior, en especial mediante técnica de vacío, del sustrato se retira en forma parcial o completa el recubrimiento con el monómero orgánico.

8. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 ó 7, **CARACTERIZADO** porque se retira el recubrimiento parcialmente en forma estructurada.

9. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 8, **CARACTERIZADO** porque después de retirar el recubrimiento en forma parcial o completa se expone el sustrato a una atmósfera reactiva, en especial, a un plasma.

10. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 9, **CARACTERIZADO** porque el recubrimiento se retira en forma estructurada de tal modo que forma una máscara para posteriores pasos de procesamiento.

8
52
49

11. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 10, **CARACTERIZADO** porque se desprende el recubrimiento mediante calentamiento y/o mediante haces de electrones, láser, radiación de fotones y/o radiación infrarroja.

12. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 11, **CARACTERIZADO** porque se desprende el recubrimiento en vacío.

13. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 12, **CARACTERIZADO** porque el retiro del recubrimiento y la elaboración posterior se realizan en la misma cámara de vacío.

14. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 13, **CARACTERIZADO** porque se utiliza como sustrato un semiconductor.

15. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 14, **CARACTERIZADO** porque se utiliza como sustrato un disco semiconductor.

16. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 15, **CARACTERIZADO** porque se utiliza como sustrato silicio monocristalino o policristalino o amorfo.

17. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 16, **CARACTERIZADO** porque se utiliza como monómero orgánico un monómero orgánico con un peso molecular bajo 1.200 dalton.

9
53
50

18. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 17, CARACTERIZADO porque se utiliza como monómero orgánico por lo menos en forma parcial una triacina.

19. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 18, CARACTERIZADO porque se utiliza como monómero orgánico por lo menos en forma parcial una 1,3,5-triacina o su sal o bien una mezcla.

20. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 19, CARACTERIZADO porque se utiliza como monómero orgánico por lo menos en forma parcial melamina, ammelina, ammelida, ácido cianúrico, 2-ureidomelamina, melamo, melemo, o sales de melamina como cianurato de melamina, fosfato de melamina, pirofosfato de melamina o polifosfato de melamina o melamina funcionalizada como hexametoxi-metilo-melamina o melamina acrilato-funcionalizada o una mezcla de ello.

21. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 20, CARACTERIZADO porque se utilizan como sustrato materiales planos.

22. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 21, CARACTERIZADO porque se utilizan como sustrato materiales con forma de banda como por ejemplo, lámina de polímeros tales como poliéster, polipropileno, propiletileno, poliamida, poliimida, policarbonato, papel, cartón, cintas metálicas o sus combinaciones.

23. Procedimiento conforme a la reivindicación 22, CARACTERIZADO porque los materiales planos están recubiertos con una

10
54
51

capa de barrera, por ejemplo, una capa de Al, una capa de SiO_x y/o una capa de AlO_x.

24. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 23, **CARACTERIZADO** porque el sustrato está provisto de otra capa de un monómero orgánico y luego se recubre este sustrato de otro modo mediante técnica de vacío.

25. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 24, **CARACTERIZADO** porque se aplica el monómero orgánico mediante un procedimiento de técnica de vacío y/o mediante lacado.

26. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 25, **CARACTERIZADO** porque se utiliza para proteger una superficie de un sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor, de influencias y/o daños químicos y/o mecánicos y/o como máscara para modificar estructuralmente las propiedades de la superficie del sustrato.

27. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 24, **CARACTERIZADO** porque se utiliza para fabricar una pieza bruta para disco o una célula solar protegida contra influencias ambientales químicas y/o mecánicas.

RETIRO FOLIOS 55, 56 y 57
DE TARJETAS Y EXTRACTO .

ESQ (P)



52

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio

~~58~~Radicación no 00-69182Concepto Técnico no 585Clasificación Internacional de Patentes B 32 B 7/00

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI ☒ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI ☒ NO ☒ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☒ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)

SE ACEPTA NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO DE FOLIOS 50 A 54

EXAMINADOR TÉCNICO

202042Bogotá D. C., 3 ABR 02

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10

Conmutador: 382 0840

Fax: 382 2695

E-mail: info@sic.gov.cowww.sic.gov.co

Bogotá, D.C., Colombia

Folio 59

2020
Bogotá DC

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Apoderada

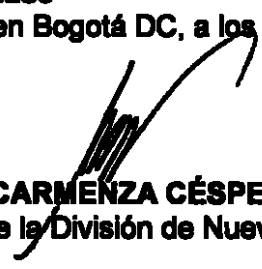
REFERENCIA:

Radicación No.	00-69182
Trámite	002
Evento	001
Actuación	416
Oficio No.	730
Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC, a los **17 ABR. 2002**


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Bogotá, DC, **Dic-2002** El extracto de esta solicitud fue publicado en el número **516**, de la Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha **30-05-02**. El término hábil señalado por la ley expiró el **29-08-02** y SI **NOX** se presentaron oposiciones por parte de terceros.



202042

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 382 2695
E-mail: info@slc.gov.co
www.slc.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDICTO No.

RADICACION: 00 69182

00001815

54

LA SECRETARIA GENERAL AD - H C

HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió la Resolución No. 40362 de 19 DIC. 2002. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y CONSIDERANDO....

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, o a quien haga sus veces, quien actúa como apoderada de Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung e.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 19 DIC. 2002

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


CARLOS GERMÁN CAYCEDO ESPINEL

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad - Hoc 05 FEB. 2003

Este edicto se desfija hoy 18 FEB. 2003 a las cinco (5:00 p.m.)

Secretaría General Ad - Hoc